

ダイオード RECTIFIER DIODES

面実装ダイオード Surface-mount Diodes

- HICおよび両面基板に実装できるように設計されています。
- 梱包形態はマガジンおよびテーブリールです。
- チップマウンターにて実装できます。

■ 単体ダイオード Single Diodes ■

品名 Type No.	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings						電気的・熱的特性 Electrical Characteristics						備考 Remarks	外形 Outline No.
	V _{RM} [V]	I _o [A]	条件 T _a [°C]	I _{FSM} [A]	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	V _F (max) [V]	条件 I _F [A]	I _R (max) V _R =V _{RM} [μA]	t _{rr} (max) [nS]	θ _{jl} (max) [°C/W]	θ _{ja} (max) [°C/W]		
D1FK20	200													
40	400	0.8	25	25	-55~+150	+150	1.2	0.8	10	300	23	108	FRD	Fig. 61
D1F10	100													
20	200													
40	400													
60	600													
D1FL20	200	1.1	25	30	-55~+150	+150	0.98	1.1	10	50	23	108	LLD	Fig. 61
D1FS4	40	1.1	25	30	-55~+125	+125	0.55	1.1	1000	—	23	108	SBD	Fig. 61
D2FK20	200													
40	400	1.3	25	50	-55~+150	+150	1.2	1.3	10	300	24	90	FRD	Fig. 62
D2F10	100													
20	200													
40	400	1.4	25	60	-55~+150	+150	1.05	1.4	10	—	24	90	—	Fig. 62
60	600													
D2FL20	200	1.6	25	50	-55~+150	+150	0.98	1.6	10	50	24	90	LLD	Fig. 62
D2FS4	40	1.6	25	60	-55~+125	+125	0.55	1.6	1000	—	24	90	SBD	Fig. 62

■ ツインダイオード(アレイタイプ) Twin Diodes(Array Type) ■

品名 Type No.	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings						電気的・熱的特性 Electrical Characteristics						備考 Remarks	外形 Outline No.
	V _{RM} [V]	I _o [A]	条件 T _a [°C]	I _{FSM} [A]	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	V _F (max) [V]	条件 I _F [A]	I _R (max) V _R =V _{RM} [μA]	t _{rr} (max) [nS]	θ _{jl} (max) [°C/W]	θ _{ja} (max) [°C/W]		
S1ZAK20	200													
40	400	0.7	25	25	-40~+150	+150	1.2	0.7	10	300	—	120	FRD	Fig. 63
S1ZA10	100													
20	200													
40	400	1.1	25	30	-40~+150	+150	1.1	1.1	10	—	—	120	—	Fig. 63
60	600													
S1ZAL20	200	1.2	25	30	-40~+150	+150	0.98	1.2	10	50	—	120	LLD	Fig. 63
S1ZAS4	40	1.1	25	30	-40~+125	+125	0.55	1.1	1000	—	25	120	SBD	Fig. 63

FRD : Fast Recovery Diode

SBD : Schottky Barrier Diode

LLD : Low Loss Diode

外形図 Outline Dimensions

[Unit : mm]

Fig. 60

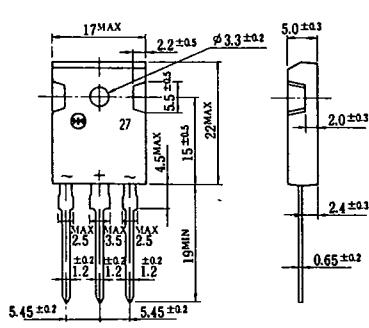


Fig. 61

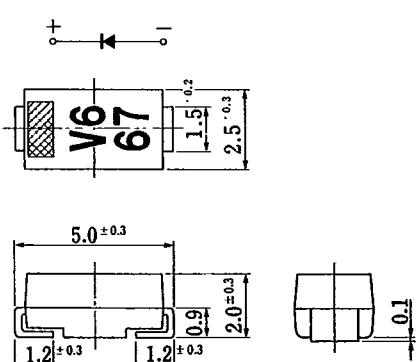


Fig. 62

